## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 21. Dezember 2000 (21.12.2000)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 00/77107 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C09G 1/02, C09K 3/14, C23F 3/00, H01L 21/306, 21/321 81667 München (DE). UNGER, Eugen [DE/DE]; Mathias-Claudiusstrasse 3H, 86161 Augsburg (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: INFINEON TECHNOLO-GIES AG; c/o Zimmermann & Partner, Postfach 33 09 20,

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,

BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/01911

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. Juni 2000 (14.06.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 27 286.7 15. Juni 1999 (15.06.1999)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Stasse 53, 81541 München (DE). Veröffentlicht:

NL, PT, SE).

Mit internationalem Recherchenbericht.

80069 München (DE).

Vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r Änderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
Frist; Ver\(\tilde{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
eintreffen.

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BEITEL, Gerhard [DE/DE]; Linprunstrasse 44, 80335 München (DE). SÄNGER, Annette [DE/DE]; Rosenheimerstrasse 79,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(54) Title: ABRASIVE SOLUTION AND METHOD FOR CHEMICALLY-MECHANICALLY POLISHING A PRECIOUS METAL SURFACE

(54) Bezeichnung: SCHLEIFLÖSUNG UND VERFAHREN ZUM CHEMISCH-MECHANISCHEN POLIEREN EINER EDEL-METALL-OBERFLÄCHE

(57) Abstract: The invention relates to an abrasive solution and a method for chemically-mechanically polishing a precious metal surface. The inertness of the precious metal surface is efficiently reduced by adding a complexing agent.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schleiflösung und ein Verfahren zum chemisch-mechanischen Polieren einer Edelmetall-Oberfläche, wobei durch den Zusatz eines Komplexbildners die Inertheit der Edelmetalloberfläche wirksam herabgesetzt wird.

1

### Beschreibung

Schleiflösung und Verfahren zum chemisch-mechanischen Polieren einer Edelmetall-Oberfläche

5

Die Erfindung betrifft eine Schleiflösung und ein Verfahren zum chemisch-mechanischen Polieren einer Edelmetall-Oberfläche, bei dem eine verbesserte Abtragsrate erzielt wird.

10

20

25

30

In herkömmlichen DRAM-Speicherbausteinen kommt als Speicherdielektrikum Siliziumoxid/Siliziumnitrid zum Einsatz. Die immer weitere Zunahme der Speicherdichte bei DRAM-Speicherbausteinen sowie die Entwicklung von sogenannten 15 nichtflüchtigen Speichern (FRAM= Ferroelectric Random Access Memory) erfordert den Einsatz von neuartigen para- oder ferroelektrischen Speicherdielektrika. Beispielsweise kommen Bariumstrontiumtitanat (BST, (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub>) oder Bleizirkonat (PZT, Pb,  $(Zr, Ti)O_3$  oder auch Strontiumbismuttantalat (SBT, SrBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub>) zum Einsatz.

Leider bedingt die Verwendung der neuen Para- und/oder Ferroelektrika auch die Verwendung neuer Elektroden- und/oder Barrierematerialien. Wegen ihrer guten Oxidationsbeständigkeit und/oder der Ausbildung elektrisch leitfähiger Oxide gelten 4d und 5d Übergangsmetalle, insbesondere Platinmetalle (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) sowie deren Oxide als aussichtsreiche Kandidaten, die dotiertes Silicium/Polysilicium als Elektrodenmaterial und z.B. Titannitrid als Barrierematerial ersetzen können. Insbesondere Platin selbst wird bei der Entwicklung innovativer DRAM und FRAM-Speicher vielfach als Elektrodenmaterial eingesetzt.

Es hat sich herausgestellt, daß diese chemisch sehr inerten 35 Elektrodenmaterialien mit den bisher bekannten herkömmlichen Schleiflösungen (Slurry) zum chemisch-mechanischen Polieren (chemo mechanical polishing, CMP) einer Edelmetalloberfläche, WO 00/77107 PCT/DE00/01911

2

die Schleifteilchen wie z.B. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub> und/oder Ceroxid etc. enthalten und mit organischen Flüssigkeiten wie Glycerin und/oder Polyalkoholen oder Glycerin/Polyalkohol/Wasser Gemischen eine Suspension bilden, nur sehr schwer zu polieren sind. Dies kommt daher, daß der Poliervorgang hier in erster Linie auf mechanische Weise erfolgt wodurch nur ein geringer Abtrag erreicht wird. Derartige Schleiflösungen sind beispielsweise aus US 5,527,423; US 5,728,308; US 5,244,534; US 5,783,489; Hoshino et al., "Chemical-Mechanical Polishing of Metalorganic Chemical-Vapor-Deposited Gold for LSI Interconnection", Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 32 (1993), S. L392-L394 sowie aus dem Fachbuch von Steigerwald et al., "Chemical Mechanical Planarization of Microelectronic Materials", Wiley 1997 bekannt.

15

35

10

Allgemein wird bei bekannten Schleifenverfahren für unedlere Metalloberflächen (wie z.B. Wolfram) der Slurry noch ein Oxidationsmittel zugesetzt, um die Metalloberfläche zu oxidieren und so durch eine zusätzliche chemische Komponente den Poliervorgang zu beschleunigen. Bei den genannten neuen Elekt-20 rodenmaterialien sind die herkömmlichen Slurries wegen deren niedriger Abtragsrate praktisch nicht verwendbar, weil die zu schleifende Oberfläche chemisch inert ist und die zugesetzten Oxidationsmittel, wenn überhaupt, nur sehr langsam abreagieren. Der Abtrag erfolgt so in erster Linie auf mecha-25 nische Weise. Dies kann aufgrund des geringen Abtrags zu sehr langen Prozesszeiten führen, bis - beispielsweise - eine Planarisierung einer Elektrode für eine Gigabit DRAM Speicherzelle mit CMP durchgeführt ist. Ferner besteht die Gefahr der Bildung von Defekten (Kratzer) auf der zu polierenden O-30 berfläche.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, eine Schleiflösung und ein Verfahren zum chemisch mechanischen Polieren einer Edelmetalloberfläche mit verbesserten Abtragsraten zur Verfügung zu stellen. 10

15

20

35

Gegenstand der Erfindung ist deshalb eine Schleiflösung zum chemisch mechanischen Polieren einer Edelmetalloberfläche, die neben Schleifpartikeln in organischer und/oder wässriger Suspension noch ein Oxidationsmittel und/oder einen Komplexbildner enthält. Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zum chemisch mechanischen Polieren einer Edelmetalloberfläche, bei dem das Oxidationspotential des Edelmetalls in der Schleiflösung über die Verschiebung des Gleichgewichts zwischen dem Edelmetall in elementarer und in ionogener (komplexierter) Form erniedrigt wird.

Nach einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung wird als Oxidationsmittel zumindest eine Verbindung, ausgewählt aus der Gruppe Sauerstoff, Ozon, Wasserstoffperoxid und Peroxodisulfat, Hypochlorit, Chlorat, Perchlorat, Bromat, Jodat, Permanganat, Chromat, Eisen(III) verbindungen, wie z.B. Fe(A) $_3$  mit A = F, Cl, Br, J, (NO $_3$ ) und/oder Fe $_2$ (SO $_4$ ) $_3$ , K $_3$ Fe(CN) $_6$ ; Cer(IV) verbindungen, wie z.B. Ce(SO $_4$ ) $_2$ , Ce(NO $_3$ ) $_4$ ; Königswasser, Chromschwefelsäure eingesetzt. Manche Oxidationsmittel können auch in Kombination als Gemisch eingesetzt werden.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung wird als Komplexbildner Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), ein Kronenether, ein stickstoffhaltiger Makrocyclus, wie z.B. ein Derivat des 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecans, Zitronensäure, Chlorid, Bromid und/oder Cyanid (die drei letzten in Form eines ihrer Salze) eingesetzt. Auch Phosphane, Phosphonate und Phosphinate sind als Komplexbildner für stabile Edelmetallkomplexe, die gebraucht werden, damit sich das Reaktionsgleichgewicht verschiebt, einsetzbar.

Nach einer vorteilhaften Ausführungsform enthält die Schleiflösung zusätzlich noch Tenside, die die Oberflächenspannung der Lösung herabsetzen und damit die Reinigung der polierten Oberflächen erleichtern. Die Tenside haben keinen Einfluß auf die gebildeten Komplexe, sie können jedoch die Benetzbarkeit der zu polierenden Oberflächen erhöhen so daß Komplexbildner WO 00/77107 PCT/DE00/01911

4

sowie Oxidationsmittel besser mit der Metalloberfläche bzw. mit mechanisch von der Oberfläche entfernten Metallteilchen in Kontakt treten können.

Bei dem Verfahren wird durch Einsatz geeigneter Komplexbildner das Gleichgewicht zwischen dem Edelmetall in elementarer Form und seinen Ionen in der Lösung zugunsten der Neubildung von Ionen (z.B. Pt2+) verschoben. Das Oxidationspotential des Edelmetalls in der Lösung wird durch die Veringerung der Metallionenkonzentration durch Komplexierung abgesenkt, so wie 10 das z.B. bei der Auflösung metallischen Goldes durch Cyanidlauge geschieht. Bei einem Edelmetall mit erniedrigtem Oxidationspotential ist eine chemisch mechanische Politur schneller abgeschlossen, weil eine Reaktion der Oberfläche sowie 15 abgetragener Teilchen des Edelmetalls mit dem eingesetzten Oxidationsmittel schneller abläuft oder erst ermöglicht wird. Ferner wird der Einsatz von schwächeren, weniger aggressiven Oxidationsmitteln möglich. Dies wiederum wirkt sich u.U. vorteilhaft auf die Lebensdauer von Anlagen sowie Arbeitsschutzmaßnahmen aus. 20

Die Komplexbildner halten ferner das abgetragene Edelmetall in Lösung, so daß Redepositionen des abgetragenen Metalls oder von Metallverbindungen verhindert werden.

25

30

35

Die Wahl des Komplexbildners ist von der Art der zu polierenden Oberfläche abhängig. Der Komplexbildner soll die Metallatome, die an der Oberfläche des zu polierenden Elements sitzen, sowie abgetragene Metallatome schnell und dauerhaft (als Metallionen) binden.

Zu jedem Edelmetall und jeder Edelmetallegierung, die vorliegend als Material des zu polierenden Elements in Frage kommen, gibt es in der Literatur viele Angaben über gute Komplexbildner in saurem oder basischem Milieu. Seit langem bewährt sind mehrzähnige Liganden (wie z.B. das EDTA), die über

WO 00/77107 - PCT/DE00/01911

5

den Chelateffekt geeignet sind, Metallionen schnell und dauerhaft in Lösung zu halten.

Der gebildete Komplex und der freie Komplexbildner sind inert und gut löslich in der Schleiflösung zum chemisch mechanischen Polieren einer Edelmetalloberfläche.

Unter der Bezeichnung "Edelmetall" wird vorliegend nicht nur ein reines Edelmetall (Ag, Au, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) verstanden, sondern jedes Metall und/oder jede Legierung mit einem Normalpotential an der Oberfläche unter Standard-

Bedingungen von größer/gleich Null. Insbesondere gedacht ist an Platin und Iridium, z.B. beim Einsatz als Elektroden und/oder Barrierematerialien in Gigabit DRAM Speicherzellen und/oder bei der Entwicklung von nichtflüchtigen FRAM Speichern (FRAM = Ferroelectric Random Access Memory).

15

WO 00/77107 PCT/DE00/01911

6

### Patentansprüche

25

- 1. Schleiflösung zum chemisch mechanischen Polieren einer Edelmetalloberfläche, die neben Schleifpartikeln in organischer und/oder wässriger Suspension noch ein Oxidationsmittel
  und/oder einen Komplexbildner enthält.
- Schleiflösung nach Anspruch 1, die als Oxidationsmittel Sauerstoff, Ozon, Wasserstoffperoxid, Peroxodisulfat, Hypochlorit, Chlorat, Perchlorat, Bromat, Jodat, Permanganat, Chromat, Eisen(III) verbindungen, Königswasser und/oder Chromschwefelsäure enthält.
- Schleiflösung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, die als
   Komplexbildner Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), einen Kronenether, stickstoffhaltige Makrocyclen, Zitronensäure, Chlorid, Bromid und/oder Cyanid enthält.
- 4. Schleiflösung nach einem der vorstehenden Ansprüche, die 20 noch ein Tensid enthält.
  - 5. Verfahren zum chemisch mechanischen Polieren einer Edelmetalloberfläche, bei dem das Oxidationspotential des Edelmetalls in der Schleiflösung über die Verschiebung des Gleichgewichts zwischen dem Edelmetall in elementarer und in ionogener und/oder komplexierter Form erniedrigt wird.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interna 11 Application No PCT/DE 00/01911

A. CLASS IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C09G1/02 C09K3/14 C23F3/0	00 H01L21/306 H	01L21/321			
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both national classif	cation and IPC				
	SEARCHED					
IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classifica C09G C09K C23F H01L C23G	tion symbols)				
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fie	elds searched			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search terms	s used)			
EPO-In	ternal, WPI Data					
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.			
X	EP 0 831 136 A (CABOT CORP.) 25 March 1998 (1998-03-25) cited in the application abstract page 5, line 34-40 page 5, last paragraph		1-4			
X	EP 0 846 742 A (CABOT CORP.) 10 June 1998 (1998-06-10) page 5, line 43-48; claims 9-11		1-4			
X	EP 0 905 754 A (SEZ SEMICONDUCTOR-EQUIPMENT ) 31 March 1999 (1999-03-31) claims 21-24	,	1,2			
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are l	isted in annex.			
* Special categories of cited documents :   T* later document published after the international filing date						
"E" earlier do filling da  "L" documer which is citation  "O" documer other m  "P" documer	nt which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document member of the same patent family				
	ctual completion of the international search	Date of mailing of the internations	al search report			
17	October 2000	27/10/2000				
Name and ma	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Girard, Y				

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

h imation on patent family members

Interna al Application No PCT/DE 00/01911

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 831136	Α	25-03-1998	US	5783489 A	21-07-1998
			US	6033596 A	07-03-2000
			US	6039891 A	21-03-2000
			AU	4589897 A	17-04-1998
			CN	1238812 A	15-12-1999
			JP	10226784 A	25-08-1998
			WO	9813536 A	02-04-1998
EP 846742	A	10-06-1998	US	5954997 A	21-09-1999
			AU	5373998 A	03-07-1998
			JP	11021546 A	26-01-1999
			WO	9826025 A	18-06-1998
EP 905754	Α	31-03-1999	JP	11162930 A	18-06-1999

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern: alea Aktenzeichen
PCT/DE 00/01911

A W. 400		4 1 2 7	<u>ie 00, 61311</u>
ÎPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C09G1/02 C09K3/14 C23F3/	H01L21/321	
Nach der II	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen I	Klassifikation und der IPK	
B. RECHE	ERCHIERTE GEBIETE		
IPK /	erter Mindestprüfstoff (Massifikationssystem und Massifikationssyr C09G C09K C23F H01L C23G		
	erte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen,		
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank	(Name der Datenbank und evtl. ve	rwendete Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data		
C. ALS WI	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	abe der in Betracht kommenden Teil	le Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 831 136 A (CABOT CORP.) 25. März 1998 (1998-03-25) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung Seite 5, Zeile 34-40 Seite 5, letzter Absatz		1-4
X	EP 0 846 742 A (CABOT CORP.) 10. Juni 1998 (1998-06-10) Seite 5, Zeile 43-48; Ansprüche	9-11	1-4
X	EP 0 905 754 A (SEZ SEMICONDUCTOR-EQUIPMENT ) 31. März 1999 (1999-03-31) Ansprüche 21-24		1,2
Weite entne	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu hmen	X Siehe Anhang Patentfami	ilie
"A" Veröffen aber nic "E" älteres C Anmeld "L" Veröffent scheine anderer soll ode ausgefü"O" Veröffent dem ber	tlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht liichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	oder dem Prioritalsdatum verö- Anmeldung nicht kollidiert, sor Erfindung zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonder kann allein aufgrund dieser Ve erfinderischer Tätigkeit beruhe "Y" Veröffentlichung von besonder kann nicht als auf erfinderisch werden, wenn die Veröffentlich	er Bedeutung; die beanspruchte Erfindung er Tätigkeit beruhend betrachtet rung mit einer oder mehreren anderen egorie in Verbindung gebracht wird und chmann naheliegend ist
Datum des At	oschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internation	alen Recherchenberichts
17	. Oktober 2000	27/10/2000	
Name und Po	stanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter Girard, Y	
	Fax: (+31-70) 340-3016	diraru, r	i

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichunge.., die zur selben Patentlamilie gehören

Interna les Aktenzeichen
PCT/DE 00/01911

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 831136	А	25-03-1998	US US AU CN JP WO	5783489 A 6033596 A 6039891 A 4589897 A 1238812 A 10226784 A 9813536 A	21-07-1998 07-03-2000 21-03-2000 17-04-1998 15-12-1999 25-08-1998 02-04-1998
EP 846742	Α	10-06-1998	US AU JP WO	5954997 A 5373998 A 11021546 A 9826025 A	21-09-1999 03-07-1998 26-01-1999 18-06-1998
EP 905754	Α	31-03-1999	JP	11162930 A	18-06-1999

٠.		,	